Облікова картка ДіР

Image not found or type unknow

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0207U000833

Державний реєстраційний номер: 0104U010929

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 09-02-2007

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: 91Нові фізичні принципи дифрактотопографії дефектів кристалів

Початок етапу: 08.2004

Закінчення етапу: 12.2005

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Код за ЄДРПОУ: 02071240

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 52-61-42

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України "Київський Політехнічний Інститут"

Код за ЄДРПОУ: 00027677

Місцезнаходження: пр. Перемоги 37, м. Київ, Київ, 03056, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 0442048428

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування:

Джерела фінансування

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Нові фізичні принципи дифрактотопографії дефектів кристалів

Назва роботи англійською:

New physical principles of diffraction topography of crystal defects

Реферат українською:

Розроблено і апробовано оригінальні пристрої до стандартних Х-променевих установок та методики проведення Х-топографічних досліджень в симетрич-ній та косонесиметричній геометрії дифракції в області кутів повного зовні-шнього відбивання та реалізації методу двокристального спектрометру. До-сліджено механізми та закономірності формування розподілів інтенсивності Х-променів у кристалах з деформованими приповерхневими шарами.

Реферат англійською:

The new original devices for standard X-ray facilities as well as techniques are de-veloped for carrying out of X-ray topographical investigations with symmetric and skew asymmetric arrangement of X-ray diffraction in the range of total external re-flection angels and realization of two-crystal spectrometer method. The mecha-nisms and regularities of X-ray intensity distribution forming in crystals with strained subsurface layers.

Індекс УДК: 539.2;538.9-405;548, 548.732:621.382

Коди тематичних рубрик: 29.19

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Фодчук Ігор Михайлович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис

1.Молодкин В.Б., Кисловский Е.М., Олиховский С.И., Фодчук И.М., Гевик В.Б. Двухкристальная рентгеновская дифрактометрия наноразмерных многослойных систем // Металлофизика и новейшие технологии. - 2003. - т.25, №12. - С.1605-1616. 2.Баловсяк С.В., Фодчук И.М. Определение параметров рельефа поверхности твердого тела в случае полного внешнего отражения рентгеновских лучей // Ме-таллофизика и новейшие технологии. - 2003. - Т.25, №7. - С.899-908. 3.Swiantek Z., Lytvynchuk I., Fodchuk I. The structural changes in porous silicon after ion implantation by phosphorous // Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics.- 2004.- V.7,№.3.- P.51-58.

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Ушенко Олександр Григорович

д. ф.-м. н., 01.04.05

Перелік осіб-виконавців

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

